

# Динамическое туннелирование электронов через квантовую точку в условиях кулоновской блокады

© С.М. Кашин<sup>†</sup>, А.М. Сатанин<sup>+, \*¶¶</sup>

<sup>†</sup> Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950 Нижний Новгород, Россия  
<sup>+</sup> Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 603950 Нижний Новгород, Россия

(Получена 8 апреля 2010 г. Принята к печати 13 апреля 2010 г.)

Исследована динамика туннелирования электронов через квантовую точку в условиях кулоновской блокады. Численно решено нестационарное уравнение Шредингера, исследована динамика многоэлектронного волнового пакета в системе, состоящей из квантовой точки, соединенной с двумя омическими контактами. Построены зависимости прозрачности от средней энергии волнового пакета. Произведено сравнение полученных зависимостей с решениями соответствующей стационарной задачи.

## 1. Введение

Исследованияnanoструктур со встроенными квантовыми точками (КТ) показывают, что кондактанс таких систем в зависимости от потенциала смещения имеет резонансную структуру [1–5]. Наличие резонансов в кондактанссе открывает широкие возможности по использованию туннельных переходов с КТ в устройствах электроники. В ряде случаев простые модели позволяют качественно объяснить наблюдаемые в эксперименте эффекты резонансного туннелирования. Однако на данный момент остается еще много проблем, связанных с многоэлектронным туннелированием через КТ. Ранее многоэлектронное туннелирование в условиях кулоновской блокады изучалось только в стационарном случае [6], когда рассматривался установившийся поток электронов через КТ. В данной работе исследуется динамическое туннелирование электронов в системе, состоящей из КТ с присоединенными к ней омическими контактами. Для этого рассматривается временное поведение многоэлектронного волнового пакета, распространяющегося в системе омические контакты—квантовая точка. Развита методика численного решения временного уравнения Шредингера для взаимодействующих электронов.

## 2. Модель и основные уравнения

Рассмотрим КТ с присоединенными к ней омическими контактами. Пусть в левом контакте формируется начальное состояние — волновой пакет, а затем рассчитывается его эволюция согласно уравнению Шредингера. Предполагается, что в КТ имеется фиксированное число уровней ( $N$ ) с энергиями  $\varepsilon_i$  ( $i$  — номер уровня) и в равновесии  $M$  из них заняты электронами [6]. При этом могут реализоваться два случая. Первый случай —

когда туннелирующий электрон находится в одном из узлов контактов ( $m \neq 0$ ), а в КТ заняты  $M$  состояний (обозначим данную комбинацию состояний индексом  $L$ ). Волновую функцию такого состояния можно представить в виде

$$\Phi_{m,L} = \hat{a}_m^+ \left\{ \prod_{i \in L} \hat{d}_i^+ \right\} |0\rangle, \quad (1)$$

где  $\hat{a}_m^+$  — оператор рождения электрона на узле  $m$ , а  $\hat{d}_i^+$  — оператор рождения электрона в КТ в состоянии  $i$ . Второй случай — когда в КТ находятся  $M + 1$  электронов (обозначим комбинацию этих  $M + 1$  занятых состояний  $L'$ ). Волновая функция в таком случае имеет вид

$$\Phi_{L'} = \left\{ \prod_{i \in L'} \hat{d}_i^+ \right\} |0\rangle. \quad (2)$$

В общем случае число возможных комбинаций из  $M$  занятых состояний равно  $\frac{N!}{M!(N-M)!}$ , и число комбинаций равно  $\frac{N!}{(M+1)!(N-M-1)!}$ , когда занято  $M + 1$  состояние. Общая волновая функция — линейная комбинация выражений (1) и (2):

$$|\Psi\rangle = \sum_{m \neq 0} \sum_L A_{m,L} \hat{a}_m^+ \prod_{i \in L} \hat{d}_i^+ |0\rangle + \sum_{L'} B_{L'} \prod_{i \in L'} \hat{d}_i^+ |0\rangle, \quad (3)$$

$A_{m,L}$  и  $B_{L'}$  — амплитуды вероятностей, которые зависят от времени  $t$ .

Гамильтониан системы имеет вид

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{QD}} + \hat{H}_t, \quad (4)$$

где  $\hat{H}_0$  и  $\hat{H}_{\text{QD}}$  — гамильтонианы электронов в контактах и в изолированной КТ,

$$\hat{H}_0 = -t_0 \sum_m (\hat{a}_{m+1}^+ \hat{a}_m + \hat{a}_m^+ \hat{a}_{m+1}), \quad (5)$$

<sup>†</sup> E-mail: smkashin@gmail.com  
<sup>¶¶</sup> E-mail: sarkady@mail.ru

$$\hat{H}_{\text{QD}} = \frac{e^2}{2C} \left( \sum_{i=1}^N \hat{d}_i^\dagger \hat{d}_i \right)^2 + \sum_{i=1}^N (e\varphi + \varepsilon_i) \hat{d}_i^\dagger \hat{d}_i, \quad (6)$$

$\hat{H}_t$  описывает туннельную связь КТ с контактами,

$$\hat{H}_t = \sum_{i=1}^N \left( V_i^L \hat{a}_{-1}^\dagger \hat{d}_i + V_i^R \hat{a}_1^\dagger \hat{d}_i + H.C. \right). \quad (7)$$

В (5)–(7) использованы следующие обозначения:  $e$  — элементарный заряд,  $C$  — эффективная емкость КТ,  $V_0$  и  $V_i$  — матричные элементы, описывающие переходы между узлами контактов и КТ (верхние индексы  $L$ ,  $R$  указывают на левый и правый контакт соответственно),  $\varphi$  — потенциал смещения на КТ.

Из временного уравнения Шредингера  $i(\partial/\partial t)|\Psi\rangle = \hat{H}|\Psi\rangle$  (выбрана система единиц, где  $\hbar = 1$ ) получаем систему уравнений для коэффициентов  $A_{m,L}$  и  $B_{L'}$ :

$$\begin{cases} i \frac{\partial}{\partial t} A_{m,L} = E_L A_{m,L} - V_0 (A_{m-1,L} + A_{m+1,L}), & j \neq 0, \pm 1, \\ i \frac{\partial}{\partial t} A_{-1,L} = E_L A_{-1,L} - V_0 A_{-2,L} + \sum_{i \in L} V_i^L B_{(L,i)}, \\ i \frac{\partial}{\partial t} A_{1,L} = E_L A_{1,L} - V_0 A_{2,L} + \sum_{i \in L} V_i^R B_{(L,i)}, \\ i \frac{\partial}{\partial t} B_{L'} = E_{L'} B_{L'} + \sum_{i \in L'} \left( V_i^{L*} A_{-1,(L',-i)} + V_i^{R*} A_{1,(L',-i)} \right). \end{cases} \quad (8)$$

Здесь индекс  $(L, i)$  обозначает заполнение КТ  $M$  электронами в соответствии с комбинацией  $L$  и еще одним электроном в состоянии  $i$ , а  $(L', -i)$  представляет комбинацию уровней  $L'$  с исключенным уровнем  $i$ . Для упрощения записи введены обозначения

$$E_L = \frac{e^2 M^2}{2C} + M e \varphi + \sum_{i \in L} \varepsilon_i, \quad (9)$$

$$E_{L'} = \frac{e^2 (M+1)^2}{2C} + (M+1) e \varphi + \sum_{i \in L'} \varepsilon_i, \quad (10)$$

$E_L$  и  $E_{L'}$  представляют собой энергии КТ с  $M$  и  $M+1$  электронами.

Решив систему уравнений (8), можно исследовать эволюцию во времени волнового пакета, распространяющегося по контакту с КТ. Амплитуды  $A_{m,L}$  зависят от номера узла  $m$ , а также от конфигурации  $L$  заполнения КТ электронами. Таким образом, при  $M > 0$  каждое уравнение в системе (8) представляет собой совокупность уравнений, соответствующих разному заполнению КТ, и задача туннелирования электронов становится многоканальной.

Рассмотрим случай, когда одно состояние КТ занято ( $M = 1$ ). Тогда  $L$  представляет собой индекс, обозначающий занятое состояние. В этом случае система (8)

примет вид:

$$\begin{cases} i \frac{\partial}{\partial t} A_{m,i} = E_i A_{m,i} - V_0 (A_{m-1,i} + A_{m+1,i}), & m \neq 0, \pm 1, \\ i \frac{\partial}{\partial t} A_{-1,i} = E_i A_{-1,i} - V_0 A_{-2,i} - \sqrt{2} \sum_{j=1}^N V_j^L B_{i,j}, \\ i \frac{\partial}{\partial t} A_{1,i} = E_i A_{1,i} - V_0 A_{2,i} - \sqrt{2} \sum_{j=1}^N V_j^R B_{i,j}, \\ \sqrt{2} i \frac{\partial}{\partial t} B_{i,j} = \sqrt{2} E_{ij} B_{i,j} + (V_i^{L*} A_{-1,j} + V_i^{R*} A_{1,j}) \\ \quad - V_j^{L*} A_{-1,i} - V_j^{R*} A_{1,i}), \end{cases} \quad (11)$$

где  $E_i = e^2/2C + e\varphi + \varepsilon_i$  и  $E_{ij} = 4e^2/2C + 2e\varphi + \varepsilon_i + \varepsilon_j$ , амплитуды  $B_{i,j}$  антисимметричны относительно перемены индексов  $i$  и  $j$ .

Движение электрона в омических контактах подчиняется первому уравнению в системе (11). Полагая контакты бесконечными, будем искать решение  $A_{m,i}$  в виде плоских волн. Нетрудно получить выражение для энергии системы:

$$E(k) = E_i - 2V_0 \cos k, \quad (12)$$

где  $k$  — волновое число, а  $E(k)$  — энергия электронов. Волновое число электрона в контакте зависит от  $E_i$ , т.е. от заполнения КТ. Таким образом, в контактах имеется  $N$  энергетических каналов.

Задавая разные начальные условия, можно, согласно (11), моделировать эволюцию произвольного состояния системы во времени. В частности, если начальное состояние формируется в виде волнового пакета в одном из открытых каналов в левом контакте, то через достаточно большое время, когда произойдет рассеяние электрона на КТ, можно определить коэффициент прохождения электрона и зависимость коэффициента прохождения от энергии, что позволит вычислить вольт-амперную характеристику (ВАХ) туннельного контакта с КТ.

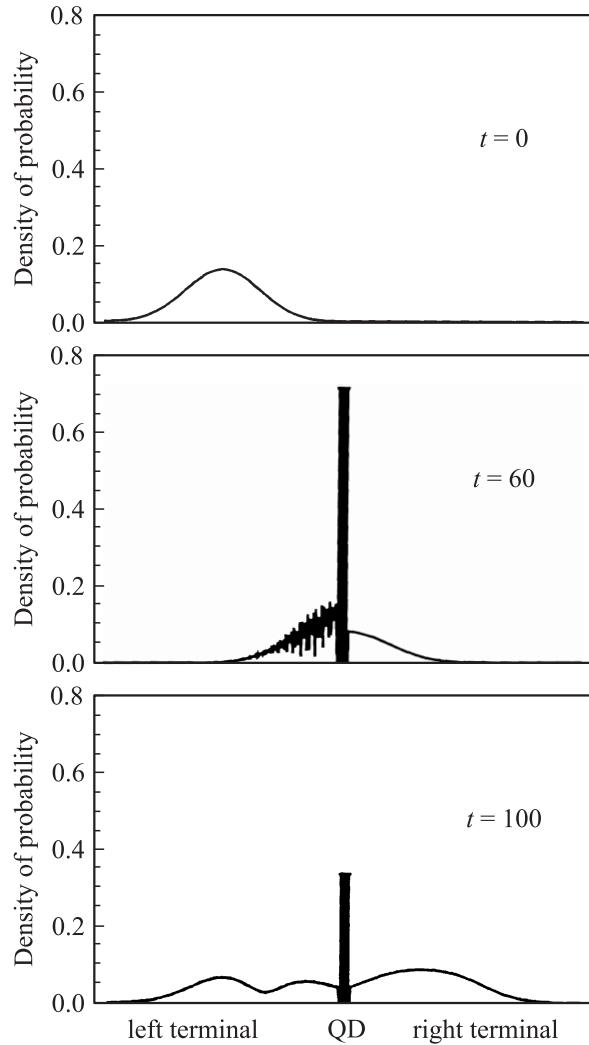
### 3. Основные результаты

Начальное состояние в  $i$ -м канале можно приготовить следующим образом. Сначала надо задать начальное распределение по волновому числу  $k$ :

$$C_m^i = \exp \left[ -\frac{(\Delta k m - k_0)^2}{\sigma_k^2} \right], \quad (13)$$

где  $k_0$  — несущее волновое число,  $\Delta k = \pi/aN_k$  — шаг сетки в первой зоне Бриллюэна. Установив положение волнового пакета  $k_0$  и его ширину  $\sigma_k$  в пространстве  $k$ , можно определить амплитуды  $A_{m,i}$ :

$$A_{m,i} = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=-N}^N C_m^i e^{i\Delta k m(j-j_0)}. \quad (14)$$



**Рис. 1.** Эволюция волнового пакета при туннелировании через КТ (QD).

Уравнения (11) с начальным условием (14) были решены численно методом Рунге–Кутты 4-го порядка. На рис. 1 изображен волновой пакет в три последовательных момента времени  $t$ . По вертикальной оси отложена сумма квадратов амплитуд  $A_{m,i}$  и  $B_{ij}$  по всем каналам, а по горизонтальной оси — координаты узлов контактов и номера состояний КТ (отмечены вертикальными линиями в центре). После отражения волнового пакета КТ остается высокая амплитуда вероятности, которая затем постепенно уменьшается, что объясняется большим временем жизни резонансных состояний в КТ.

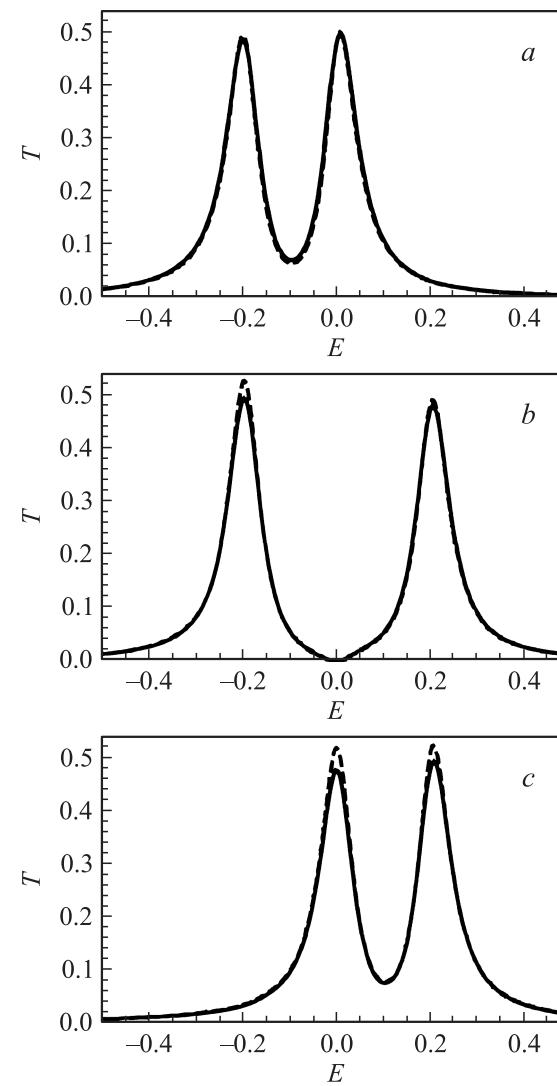
Если приготовить распределение (13), которое сильно локализовано в  $k$ -пространстве, то коэффициент прохождения будет совпадать с решением стационарного уравнения Шредингера. Прозрачность в нестационарной задаче можно вычислить, проследив эволюцию системы за большое время. Волновой пакет туннелирует через КТ, часть его отразится, а часть пройдет в правый контакт. Тогда коэффициент прохождения можно найти

по формуле

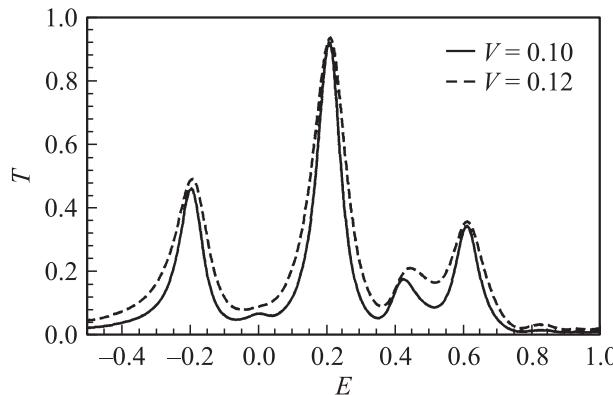
$$T(k_0) = \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^n |A_{m,i}|^2, \quad (15)$$

где суммирование идет по всем каналам и узлам правого контакта, а также учтено, что в начальный момент  $\sum_{i=1}^N \sum_{m=-n}^n |A_{m,i}|^2 = 1$ .

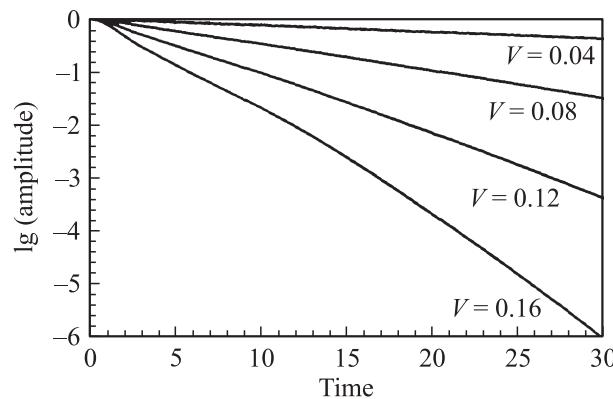
На рис. 2 представлены зависимости коэффициента прохождения от средней энергии волнового пакета  $E$ . При этом полагалось, что в КТ имеется  $N = 3$  уровня, а параметры системы взяты следующими:  $\Delta\epsilon = \epsilon_{i+1} - \epsilon_i = 0.2$ ,  $e^2/2C = 0.3$ ,  $V_i^R = V_i^L \equiv V = 0.10$ ,  $e\varphi = -1.5$ ; в качестве единицы энергии выбран резонансный туннельный интеграл  $V_0$ . Пунктирными ли-



**Рис. 2.** Зависимость коэффициента прохождения  $T$  от средней энергии волнового пакета (сплошные кривые): начальное состояние формировалось в 1-м канале (a), во 2-м канале (b) и в 3-м канале (c). Штриховые линии — парциальные коэффициенты прохождения в соответствующие каналы, полученные из решения стационарной задачи.



**Рис. 3.** Зависимость коэффициента прохождения  $T$  волнового пакета от средней энергии  $E$ . Начальное состояние задавалось в виде суперпозиции пакетов во всех каналах.



**Рис. 4.** Зависимость амплитуды вероятности нахождения электрона в КТ от времени при различных значениях параметра связи КТ и kontaktами.

ниями обозначены решения стационарной задачи для системы с аналогичными параметрами. Как видно из рисунков, кривые почти во всем диапазоне энергий совпадают, что говорит о корректности выбранного метода решения уравнений (11) и расчета коэффициента прохождения. Небольшие различия прозрачности вблизи максимумов объясняются тем, что в волновом пакете присутствуют гармоники с нерезонансной энергией, которые не проходят в правый контакт.

Можно задавать начальное состояние в виде суперпозиции состояний в различных каналах. При этом, чтобы средняя энергия волнового пакета была одинаковой в разных каналах, необходимо вычислять  $k_0$  начального состояния для каждого канала согласно (10). На рис. 3 приведены зависимости коэффициента прохождения от средней энергии волнового пакета при двух значениях параметра связи КТ с kontaktами  $V$  (для простоты выбрано  $V_i^R = V_i^L \equiv V$ ), начальное состояние задавалось во всех  $N = 4$  каналах, другие параметры взяты следующими:  $\Delta\epsilon = \epsilon_{i+1} - \epsilon_i = 0.2$ ,  $e^2/2C = 0.3$ ,  $e\varphi = -1.5$ . Наблюдаются резонансы, положение которых определяется энергиями двухчастичных состояний в КТ. При

этом зависимость прозрачности от энергии не является суммой соответствующих зависимостей с начальными состояниями, заданными в отдельных каналах, поскольку происходит интерференция волновых пакетов из разных каналов. Прохождение через КТ определяется параметром  $V$ . Как видно из рисунка, при увеличении  $V$  увеличивается ширина резонансов. Положение резонансов определяется энергиями многочастичных состояний в квантовой точке.

Если в начальный момент времени оба электрона находятся в КТ, то решение временного уравнения Шредингера позволит изучить распад двухчастичного состояния. Исследования подобных явлений в одноэлектронном приближении [7] показывают, что амплитуда вероятности есть

$$A = \exp(iEt) \exp(-\Gamma t/2), \quad (16)$$

где  $E$  — энергия квазистационарного состояния, а  $\Gamma$  — ширина резонанса. На рис. 4 приведена временная зависимость амплитуды вероятности (в логарифмических координатах) нахождения электрона в КТ при различных значениях параметра связи КТ с kontaktами  $V$ . Как видно из рисунка, при малых значениях  $V$  логарифм амплитуды — линейная функция времени, ее производная определяет ширину резонанса, вблизи которого задано начальное состояние. При увеличении  $V$  наблюдается отклонение от линейного поведения, которое можно объяснить тем, что становится существенным перекрытие резонансов и происходит интерференция состояний, локализованных на близких квазиуровнях.

#### 4. Заключение

В одноканальном приближении нестационарная задача туннелирования через КТ сводится к задаче о движении волнового пакета через двухбарьерную структуру, где наблюдается полное прохождение при энергиях, равных энергиям квазистационарных состояний между барьерами. В данной работе исследована динамика двухэлектронного волнового пакета в системе с КТ в многоканальном случае. С увеличением числа электронов в КТ  $M$  число уравнений системы (9) растет как  $N^M$ , что существенно осложняет расчет. Однако уже при минимальном заполнении КТ,  $M = 1$ , становятся видны основные особенности динамики волнового пакета. Происходит интерференция пакетов из разных энергетических каналов. Резонансы наблюдаются только при туннелировании из открытых каналов. Предлагаемый в работе метод решения уравнения Шредингера позволяет исследовать эволюцию произвольного начального состояния. Если в первый момент времени волновой пакет находится на КТ, то его дальнейшая эволюция описывает распад состояния. При увеличении параметра  $V$  зависимость логарифма плотности вероятности нахождения электронов в КТ становится нелинейной, что объясняется участием в распаде нескольких резонансов и их интерференцией.

Если в начальный момент времени пакет локализован на одном из узлов, то амплитуда в последующий момент времени представляет собой двухчастичную функцию Грина, которая определяет транспортные свойства системы. Это свойство может быть использовано для расчета вольт-амперной характеристики контактов со встроенной КТ. Расчет транспортных характеристик многоэлектронной системы с КТ методом функций Грина в одноканальном приближении рассматривается в работах [8,9]. Исследуемый в работе метод численного решения предполагается использовать для изучения ВАХ систем с КТ в условиях кулоновской блокады в многоканальном случае.

## Список литературы

- [1] A. Yacoby, R. Schuster, M. Heiblum. Phys. Rev. B, **53**, 9583 (1996).
- [2] J. Göres, D. Goldhaber-Gordon, S. Heemeyer, M.A. Kastner, H. Shtrikman, D. Mahalu, U. Meirav. Phys. Rev. B, **62**, 2188 (2000).
- [3] U.F. Keyser, S. Borck, R.J. Haug, M. Bichler, G. Abstreiter, W. Wegscheider. Semicond. Sci. Technol., **17**, L22 (2002).
- [4] K. Kobayashi, H. Aikawa, A. Sano, S. Katsumoto, Y. Iye. Phys. Rev. B, **70**, 035319 (2004).
- [5] A. Vidan, R.M. Westervelt, M. Stopa, M. Hanson, A.C. Gossard. Appl. Phys. Lett., **85**, 3602 (2004).
- [6] Shi-Jie Xiong, Ye Xiong. Phys. Rev. Lett., **83**, 1407 (1999).
- [7] Н.С. Крылов, В.А. Фок. ЖЭТФ, **17**, 93 (1947).
- [8] C. Caroli, R. Combescot, P. Nozieres, D. Saint-James. J. Phys. C: Sol. St. Phys., **4**, 916 (1971).
- [9] S. Hershfield, J.H. Davies, J.W. Wilkins. Phys. Rev. B, **46**, 7046 (1992).

*Редактор Л.В. Шаронова*

## Dynamical tunneling of electrons through a quantum dots in Coulomb blockade regime

S.M. Kashin<sup>+</sup>, A.M. Satanin<sup>+,\*</sup>

<sup>+</sup> Physical-Technical Research Institute

N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,  
603950 Nizhny Novgorod, Russia

\* Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,  
603950 Nizhny Novgorod, Russia

**Abstract** Dynamical tunneling of electrons through a quantum dot in Coulomb blockade regime has been investigated. The time-dependent Schrodinger equation for a many-electron wave packet propagating through the quantum dot connected with two ohmic leads has been solved. Transmittance as a function of the average electron energy has displayed. The calculated results of the dynamical problem have been compared with the related solutions of the time-independent problem.

*Окончание публикации материалов симпозиума*